

SG211V

SG211Vは、高出力赤外発光ダイオードと、高感度フォトトランジスタを組合わせた透過型フォトインタラプタです。高精度位置検出に適した汎用インタラプタです。

The SG211V photointerrupter high-performance standard type, combines high-output GaAs IRED with high sensitive phototransistor.

■特長 FEATURES

- 基板直付けタイプ
- ギャップ幅: 2.0mm
- 小型
- ローコスト

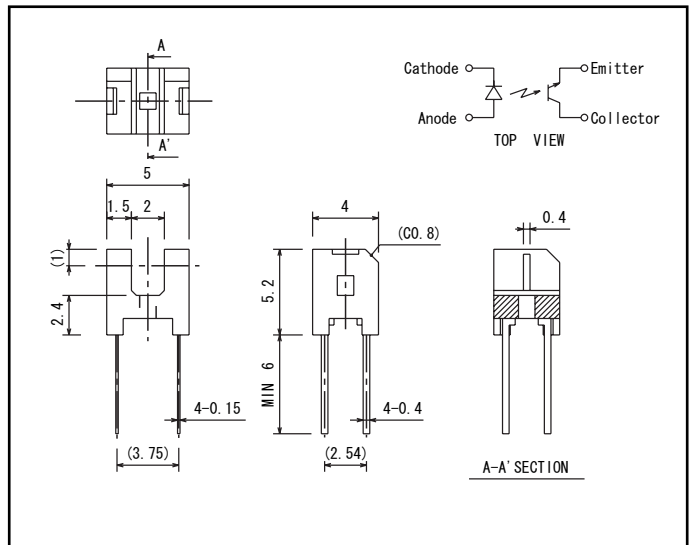
- PWB direct mount type
- GAP : 2.0mm
- Compact
- Low cost

■用途 APPLICATIONS

- フロッピーディスクドライブ
- CD-ROM
- プリンター
- FAX
- カメラ

- Floppy disk drives
- CD-ROM drives
- Printers
- Facsimiles
- Cameras

■外形寸法 DIMENSIONS (Unit : mm)



■最大定格 MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

| Item | | Symbol | Rating | Unit |
|-------------------------|--|-------------------|----------|------|
| 入力 Input | 許容損失 Power dissipation | P _D | 75 | mW |
| | 順電流 Forward current | I _F | 50 | mA |
| | 逆電圧 Reverse voltage | V _R | 5 | V |
| | パルス順電流 Pulse forward current *1 | I _{FP} | 0.5 | A |
| 出力 Output | コレクタ損失 Collector power dissipation | P _C | 75 | mW |
| | コレクタ電流 Collector current | I _C | 20 | mA |
| | コレクタ-エミッタ間電圧 Collector-Emitter voltage | V _{CE0} | 30 | V |
| | エミッタ-コレクタ間電圧 Emitter-Collector voltage | V _{EC0} | 5 | V |
| 動作温度 Operating temp.*2 | | T _{opr.} | -20~+85 | °C |
| 保存温度 Storage temp.*2 | | T _{stg.} | -30~+100 | °C |
| 半田付温度 Soldering temp.*3 | | T _{sol.} | 260 | °C |

*1. パルス幅: t_w ≤ 100 μs 周期: T=10ms
pulse width: t_w ≤ 100 μs period: T=10ms

*2. 氷結、結露の無き事
No icebound or dew

*3. ケース端面より 1mm離れた所で t ≤ 5s
For MAX. 5 seconds at the position of 1mm from the resin edge

■電氣的・光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

(Ta=25°C)

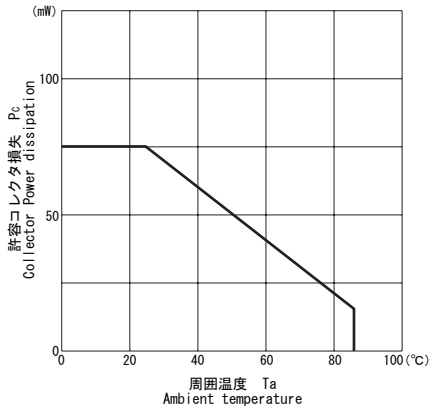
| Item | | Symbol | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit. |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------|---|------|------|------|-------|
| 入力 Input | 順電圧 Forward voltage | V _F | I _F =20mA | — | 1.2 | 1.4 | V |
| | 逆電流 Reverse current | I _R | V _R =5V | — | — | 10 | μA |
| | ピーク発光波長 Peak wavelength | λ _p | I _F =20mA | — | 940 | — | nm |
| 出力 Output | 暗電流 Collector dark current | I _{CE0} | V _{CE} =10V, 0 I _x | — | 1 | 100 | nA |
| 伝達特性 Transmission | 光電流 Light current | I _C | I _F =10mA, V _{CE} =5V, 入光状態 (Non-Shading) | 0.25 | — | 1.2 | mA |
| | 漏れ電流 Leakage current | I _{CE00} | I _F =10mA, V _{CE} =5V, 遮光状態 (Shading) | — | 0.5 | 10 | μA |
| | コレクタ-エミッタ間飽和電圧 C-E saturation voltage | V _{CE(sat)} | I _F =10mA, I _C =0.03mA | — | 0.15 | 0.4 | V |
| 応答時間 (立ち上がり) Rise time | | t _r | V _{CC} =5V, I _C =0.1mA, R _L =1kΩ | — | 50 | — | μs |
| 応答時間 (立ち下がり) Fall time | | t _f | | — | 50 | — | μs |

本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、内容の確認をお願い致します。

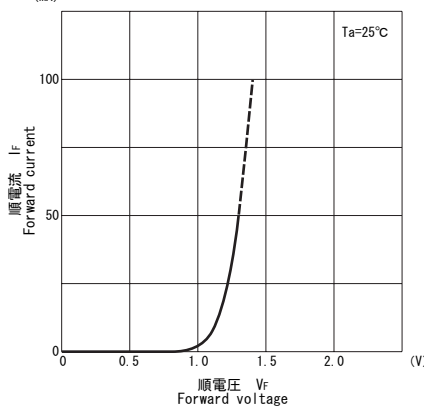
The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, would you please refer to the latest specifications.

SG211V

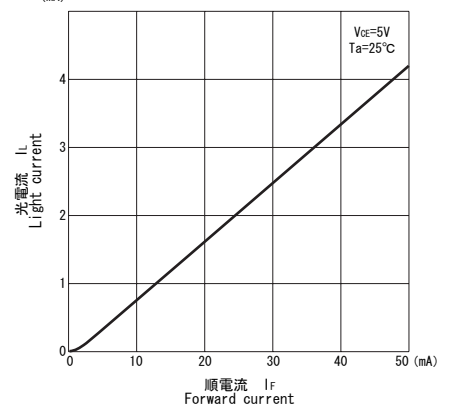
■許容コレクタ損失/周囲温度 P_c/T_a



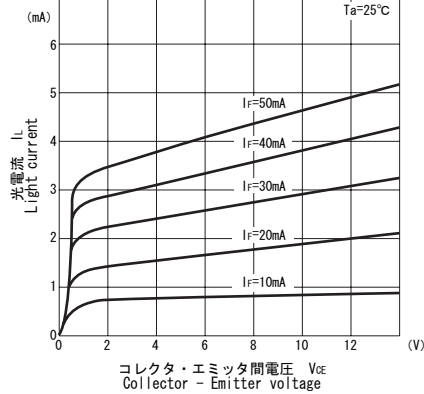
■順電流/順電圧特性 I_F/V_F



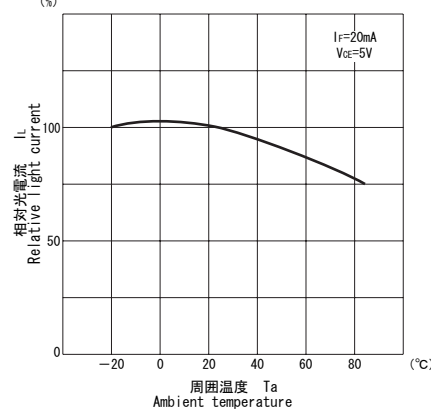
■光電流/順電流特性 I_L/I_F



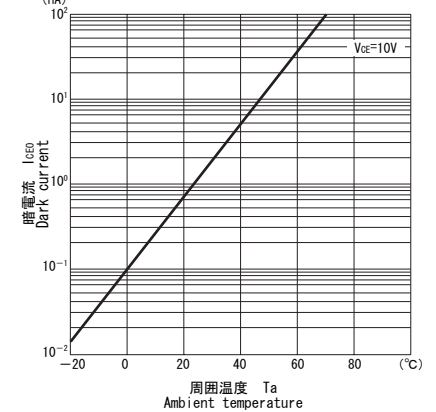
■光電流/コレクタ・エミッタ間電圧特性 I_L/V_{CE}



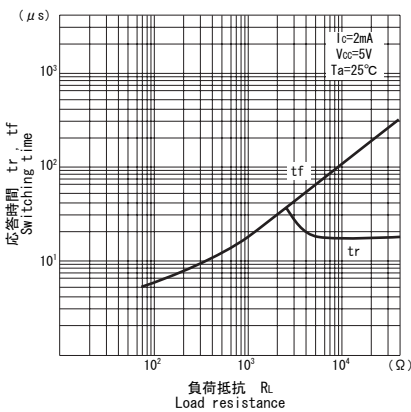
■相対光電流/周囲温度特性 I_L/T_a



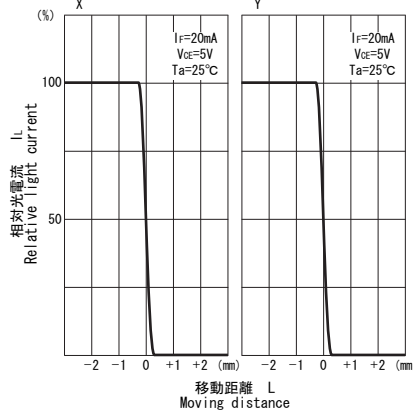
■暗電流/周囲温度特性 I_{CE0}/T_a



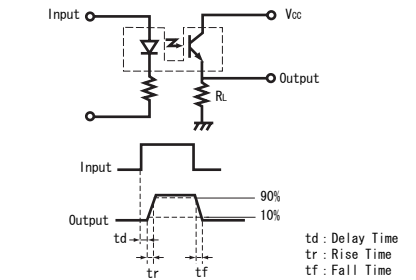
■応答時間/負荷抵抗特性 $t_r, t_f/R_L$ ※1



■位置検出特性 ※2



*1 Switching time measurement circuit



*2 Method of measuring position detection characteristic

